

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XDN150	文件编号	XS-D-003
	NPN 型达林顿晶体管	版本号	16-A3-05
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

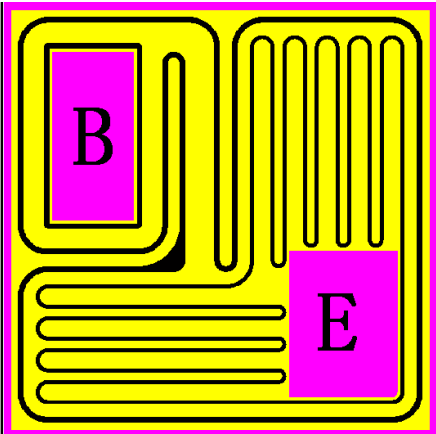
1.1 主要用途

W2XDN150 封装的成品管，主要用于小信号的功率放大电路中。

1.2 主要特点

- 高温特性好
- 共发射极正向电流传输比 h_{FE} 大
- 反向漏电小

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	1.50×1.50	
	芯片厚度 (μm)	250±20	
	划片道*尺寸 (μm)	50	
	键合区面积 (μm ²)	基区	280×580
		发射区	374×506
	钝化层		Si ₃ N ₄
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	4.5±1
	背面电极	表层金属	银
	硅片直径 (mm)	φ125	
	装片要求 (推荐)	铅锡银	
键合要求 (推荐)	铜丝; E区: φ42 μm, 两根; B区: φ42 μm, 一根;		

* 划片道位置示意图:



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XDN150	文件编号	XS-D-003
	NPN 型达林顿晶体管	版本号	16-A3-05
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	150	V	推荐封装形式: to-126 推荐成品型号: TIPP112 
集电极-发射极电压	V_{CE0}	100	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	7	V	
集电极电流	I_C	5	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	1.25	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=150\text{V}, I_E=0$			10	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=7\text{V}, I_C=0$			100	mA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=3\text{A}$	1k			
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=3\text{A}, I_B=12\text{mA}$			2	V

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532